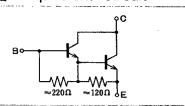
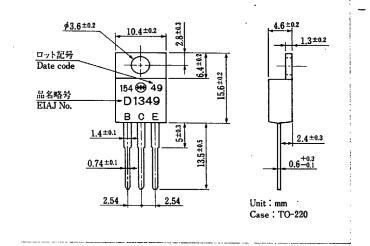
NPNダーリントントランジスタ/ NPN Darlington Transistor



等価回路 Equivalent Circuit



外形寸法図 Outline Dimensions



絶対最大定格 Absolute Max. Ratings

項 Item		記 号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単 位。 Unit	
保存温度 Storage Temperature		Tstg		-55~+150	င	
接合部温度 Junction Temperature		Tj		+150	ъ	
コレクタ・ベース電圧 Collector to Base Voltage		Vсво		500	v	
コレクタ・エミッタ電圧 Collector to Emitter Voltage		VCEO		400	v	
エミッタ・ベース電圧 Emitter to Base Voltage		VEBO		12	v	
コレクタ電流 Collector Current	DC	Ic		7	A	
	Peak	ICP		14		
ベース電流 Base Current	DC	Ів		0.5	A	
	Peak	Івр		1		
トランジスタ損失 Total Transistor Dissipation		Рт	Tc=25℃	50	w	
締め付けトルク Mounting Torque		TOR	(推奨値:3kg·cm) (Recommended torque:3kg·cm)	5	kg·cm	

電気的·熱的特性 Electrical Characteristics (Tc=25℃)

コレクタ・エミッタ電圧 Collector to Emitter Sustaining Voltage	VCEO(sus)	VCE(Clamp)	MIN	400	v
コレクタ遮断電流	Ісво	Vcb=500V	MAX	0.1	mA
Collector Cutoff Current	ICEO	Vce=400V	MAX	0.1	
エミッタ遮断電流 Emitter Cutoff Current	Іево	VEB=12V	MAX	100	mA
直流電流増幅率	hFE	Vce=2V. Ic=7A	MIN	150	
DC Current Gain		VCE-2V, IC=/A	MAX 5,000		
コレクタ・エミッタ飽和電圧 Collector to Emitter Saturation Voltage	VCE(sat)	In-7A In-70A	MAX	1.5	v
ベース・エミッタ飽和電圧 Base to Emitter Saturation Voltage	VBE(sat)	IC=7A, IB=70mA	MAX	2.0	v
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{ m jc}$	接合部・ケース間 Junction to case	MAX	2.5	°C/W
トランジション周波数 Transition Frequency	fт	VcE=10V, Ic=1A	STD	10	MHz
ターンオン時間 Turn on Time	ton	IB1=IB2=70mA	MAX	2	μS
蓄積時間 Storage Time	ts	$ \begin{array}{c} IC=7A\\RL=10\Omega \end{array} $	MAX	12	μS
下降時間 Fall Time	tf	VBB2=4V	MAX	9	μS

特性図 Characteristic Diagrams

